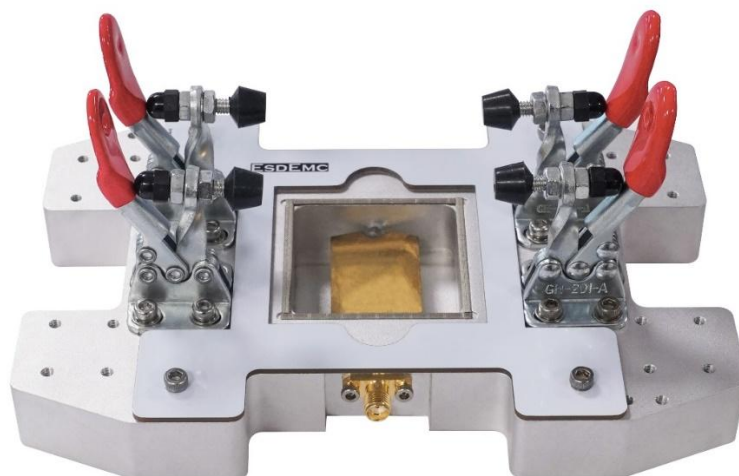


EM601-8 IC 带状线 TEM 小室



1. 说明

ESDEMC 的 EM601-8 是直流至 8 GHz 的 IC-Stripline TEM 单元，可产生用于测试 IC、无线通信模块等小型设备的电磁场。通过 EM601-8 的输入端口施加外部测试信号，可在电池内部产生一致且可预测的 TEM 测试场。设备在 TEM 单元内发射的辐射场可通过端口使用测试接收器进行测量。

独特的紧凑型经济设计经过优化，可用于标准 TEM Cell 频率范围以外的中等精度测量。EM601-8 的工作原理与 TEM Cell 基本相同。测试体积内的 E-H 场与输入电压成正比，与电池高度成反比。如果在样品池内插入一个辐射物体，向输入端口的辐射波会被传输线引导，并在输入端用接收器（如频谱分析仪）进行测量。利用这种方法，可以定量测量设备的射频辐射。由于这种仪器的频带非常宽，因此在 EMI、EMS、接收器灵敏度测试等领域应用广泛。

2. 特点

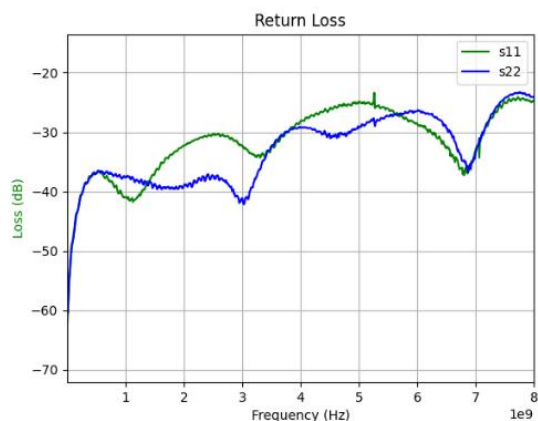
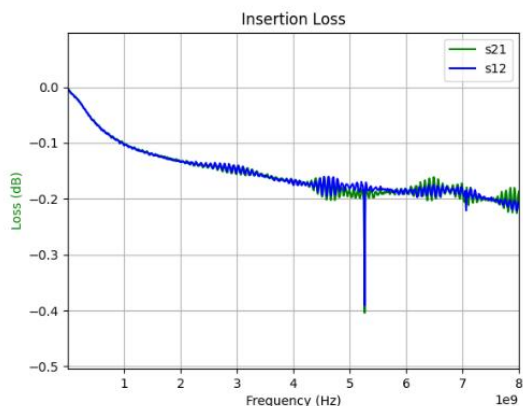
- 高达 8 GHz 的带宽（超出 常见 1 GHz 的 TEM Cell 带宽）
- 可在 53 dBm 输入功率下测试到 12.5 kV/m（最大额定值）

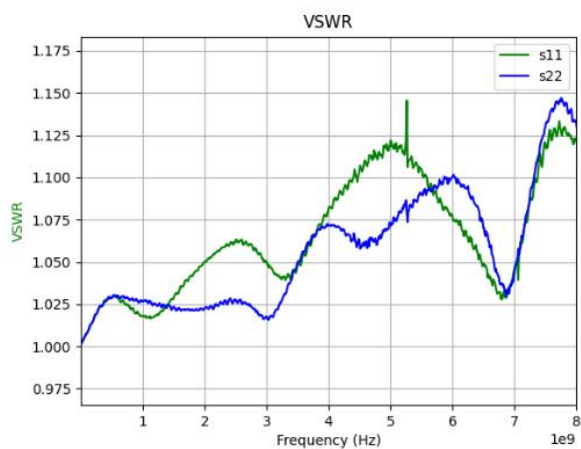
3. 应用

- 集成电路的电磁抗扰度测试
- 集成电路电磁辐射测试
- 集成电路的静电放电/浪涌场敏感性测试
- 设计符合以下标准的要求：
 - SAE 1752-3
 - IEC 61967-2
 - IEC 61967-8
 - IEC 62132-2
 - IEC 62132-8

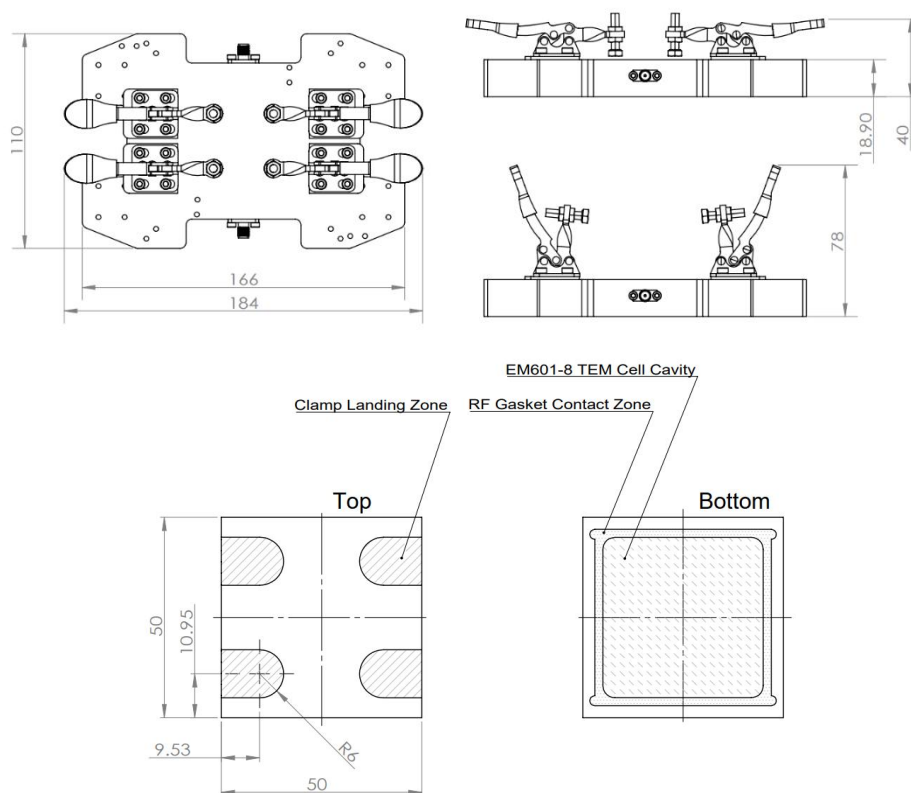
4. 规格

规格	Parameters			
频响范围	DC to 8 GHz (第一个尖峰 > 8 GHz 时才会出现)			
TEM 单元阻抗	50 $\Omega \pm 5\%$			
标准	IEC 61967-2	IEC 61967-8	IEC 62132-2	IEC 62132-8
VSWR	DC – 8 GHz < 1.4	DC – 8 GHz < 1.4	DC - 8 GHz < 1.2	DC – 8 GHz < 1.25
插入损耗 (S21)	DC – 8 GHz < 1 dB	DC – 8 GHz < 1 dB	DC – 8 GHz < 1 dB	DC – 8 GHz < 1 dB
屏蔽底板到壁高度	8.0 mm			
单元中心电场强度	125 V/m @ 1V (max 12.5 kV/m @ 200 W-rms, 125 kV/m @ 1kV pulse)			
电场中心的 H 场强	= E 场强 / 377 (A/m)			
射频连接器	SMA			
最大输入功率	200 W-rms, 53 dBm			
最大输入电压	100 V-rms, 1 kV TLP 脉冲			
DUT 端口尺寸	40 (L) x 40 (W) mm			
最大 DUT 尺寸	50 (L) x 50 (W) mm 100 (L) x 100 (W) mm 110 (L) x 110 (W) mm			
DUT 测试板尺寸	24 (L) x 24 (W) x 2 (H) mm			
TEM 单元尺寸	166 (L) x 110 (W) x 20 (H) mm			
重量	约 0.5 kg			





5. 尺寸



Recommended Board Thickness: 1.6mm

6. 订购信息

	型号	说明	状态
1	EM601-8	EMC601-8 IC Stripline TEM Cell, DC-8 GHz	在库